

描述

NE3385 是一款高可靠性智能双通道同步整流控制器,应用于半桥 LLC 谐振变换器的输出侧整流,可实现对 MOSFET 的优化控制,取代肖特基二极管,提高半桥 LLC 变换器的效率。

NE3385 具有轻载模式功能,实现 LLC Skip 模式下针对性优化,改善 Skip_OFF 下 HB 震荡时,SR 误触发开通问题。NE3385 具有节能模式,当负载电流降低到一定程度时,将栅极驱动及非必要电路关闭,从而将 IC 损耗电流限制在 110uA 以下。

NE3385 的快速关断能力可支持连续导通模式 (CCM) 和断续导通模式 (DCM) 工作。

该 IC 集成度高,外围设计精简,采用 SOP-8 和 ESOP-8 两种封装,后者封装热阻小,散热改善。

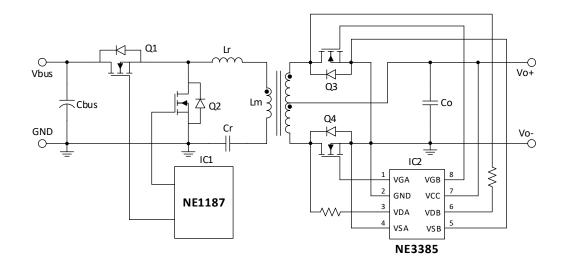
特点

- VDA, VDB 对地最大电压 120V
- VCC 工作范围宽,支持 5V~36V 的电压应用
- IC 待机节能时,实现 110uA 低静态电流
- 快速关断,适用于 CCM, CRM 和 DCM 工作模式
- 双通道独立差分采样
- VDS 阈值偏置电阻设置
- 针对系统频率,配置优化性能
- 外围简单,性价比高
- 互锁功能防止直通工作
- SOP-8/ESOP-8 封装

应用

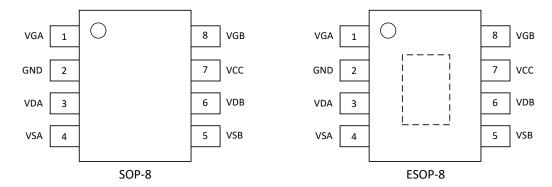
- AC/DC 适配器
- PD 快充电源
- PC 电源或一体机电源
- LCD 电视电源
- 工业, 医疗等其它电源

典型应用电路图





引脚封装



引脚功能描述

| 名称 | 序号 | 描述 |
|-----|----|--------------------------|
| VGA | 1 | 通道 A 的 MOS 管驱动输出 |
| GND | 2 | 功率地,驱动电流路径 |
| VDA | 3 | 通道 A 的 MOS 管 Drain 电压检测脚 |
| VSA | 4 | VDA 和 VDB 的电压采样信号参考 |
| VSB | 5 | VDA 和 VDB 的电压采样信号参考 |
| VDB | 6 | 通道 B 的 MOS 管 Drain 电压检测脚 |
| VCC | 7 | IC 供电脚,最高应用电压 36V |
| VGB | 8 | 通道 B 的 MOS 管驱动输出 |

订购信息

| 型号 | 封装 | Logo | 最小包装 |
|---------|--------|---------|---------|
| NE3385 | SOP-8 | NE3385 | 4000PCS |
| NE3385A | SOP-8 | NE3385A | 4000PCS |
| NE3385B | ESOP-8 | NE3385B | 4000PCS |



极限参数

| 参数 | 极限值 | 单位 |
|--------------------------------|-------------------------|------|
| VCC to GND | -0.3~40 | V |
| GND to VSS | -0.3~0.3 | V |
| VG to GND | -0.3~20 | V |
| VDA、VDB to VSS | -1.2~120 ⁽²⁾ | V |
| 最大承受功耗 (Ta = 25°C) | 1.4 | W |
| 最大结温 | 150 | °C |
| 焊锡温度(焊锡,10秒) | 260 | °C |
| 存储温度 | -55~150 | °C |
| θ _{JA} ⁽³⁾ | 90 | °C/W |
| θ _{JC} ⁽³⁾ | 45 | °C/W |

注

- 1. 最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。
- 2. 重复脉冲宽度<200ns。
- 3. 测试数据基于指定 PCB。

推荐工作范围

| 参数 | 值 | 单位 |
|----------------|-------------|----|
| VCC to GND | 5 to 36 | V |
| VDA、VDB to VSS | -0.7 to 100 | V |
| Тј | -40~125 | °C |

注

热阻信息

| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
|----------|------|------|----|
| VESD_HBM | 人体模型 | 2000 | V |
| VESD_CDM | 放电模型 | 500 | V |

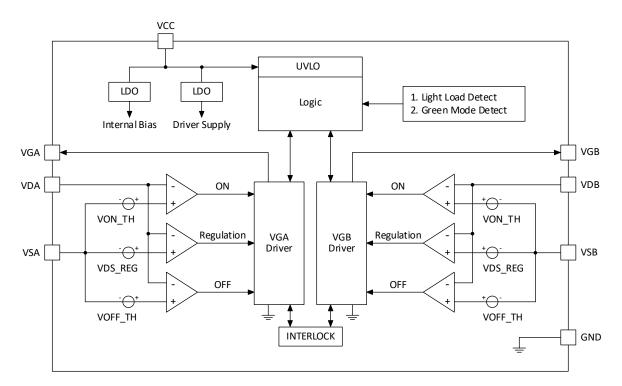
注

^{1.} 芯片不保证在其工作条件之外运行的可靠性。

^{1.} 测试数据基于指定 PCB。



内部框图





电气参数

(TA = 25°C, VCC = 12V, 除非特别注明)

| | / 1.4: 1/ 14 | × × - | | | | |
|-------------|--------------|---|------------|------|------|----|
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源管理 VC | C | | | | | I |
| VCC_ON | 启动电压 | | 4.25 | 4.5 | 4.75 | V |
| VCC_HYST | 欠压保护迟滞 | | | 0.2 | | V |
| IQ | 静态电流 | IC 工作,但无 GATE 驱动,VDA = VDB = 0V | | 0.9 | | mA |
| ICC | 工作电流 | VCC = 12V,fsw = 100kHz | | 4.7 | | mA |
| IGM | 节能电流 | 节能模式下,VDA = VDB = 3V | | 110 | | uA |
| VDA/VDB-VSS | 5 检测与控制部分 | | | | | I |
| VDS_REG | 调整电压目标值 | | | -25 | | mV |
| VON_TH | 驱动开通阈值 | | -400 | -350 | -300 | mV |
| VOFF_TH | 快速关断阈值 | | | 100 | | mV |
| ID_LK | VDA, VDB 漏电流 | | | | 1 | uA |
| TD_ON1 | 重载开通延时 | C _{LOAD} = 10nF | | 80 | | ns |
| TD_ON2 | 轻载模式开通延时 | C _{LOAD} = 10nF | | 240 | | ns |
| TD_OFF | 关断延时 | C _{LOAD} = 10nF | | 30 | | ns |
| TD ON | 开通消隐时间 | C _{LOAD} = 4.7nF(NE3385A,NE3385B 版本) | | 0.35 | | |
| TB_ON | | C _{LOAD} = 4.7nF(NE3385 版本) | | 0.7 | | us |
| TD OFF | 关断消隐时间 | CLOAD = 4.7nF(NE3385A,NE3385B 版本) | 5B 版本) 0.7 | | | |
| TB_OFF | 大明相隐时间 | C _{LOAD} = 4.7nF(NE3385 版本) | | 1.4 | us | |
| 节能控制 | | | | 1 | | |
| VB_TH | SR 断态判断阈值 | | 1.5 | 1.75 | 2 | V |
| TGM_ENT | 节能判断时间 | 驱动 A 和 B 均未触发持续时间 | | 60 | | us |
| 驱动部分 | | | | 1 | | |
| VGC | 驱动钳位电压 | VCC = 12V~36V | | 10.5 | 12 | V |
| VGL | 输出低电平 | VDS > 3V | | | 0.7 | V |
| IVGH | 最大灌电流 | | | 1.2 | | Α |
| IVGL | 最大拉电流 | | | 2.5 | | Α |
| RSINK | 下拉电阻 | ILOAD = 100mA | | 1 | | Ω |



功能描述

NE3385 是一款应用于半桥 LLC 谐振变换器输出侧整流的双通道控制器,可支持 CCM, CRM 和 CCM 工作,并自动实现优化控制。NE3385 外围简单,保护可靠。下面的章节分别详细介绍它的各个功能模块。

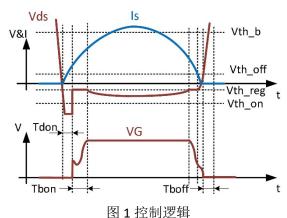
VCC 启动及欠压锁定(UVLO)

NE3385 的 VCC 最大电压可高达 40V。在输出电压高达 36V 的应用时,可支持 VCC 引脚直接连接到输出电压。当 VCC 电压低于 UVLO 阈值时,NE3385 的驱动输出保持为低电平,且进入休眠模式。当 VCC 电压大于 UVLO 时,IC 内部电路开始工作。

驱动开通和关断

当电流流过同步整流 MOSFET 的体二极管时,VDS 电压远低于开启门限 VON_TH,经过 TD_ON 的延迟后,IC 开启驱动输出,如图 1 所示。TD ON 在满载时是 80ns,在轻载时是满载时的 3 倍,为 240ns。

当 MOS 管开启后,如果流过的开关电流较小,VDS 正向压降超过 VDS_REG 时,NE3385 将降低栅极电压来增大 MOS 的导通电阻。通过这种控制原理,将 VDS 电压调节到 VDS_REG,保证 MOSFET 在电流相当低的情况下仍然保持导通,尽量的减小体二级管的导通时间。在 CCM 模式时,这个功能使得当 SR MOS 关断时,栅极电压保持在一个很低的电平,提高了关断速度。



当 VDS 上升到关闭阈值 VOFF_TH 时,Gate 驱动电压在非常短的关闭延迟之后被拉到 0V。Gate 驱动电压开始关断时,关断屏蔽时间开始计时,在 TB OFF 时间内,栅极驱动器保持关闭。

建议在 VDA、VDB 串 $10\Omega^{\sim}510\Omega$ 的电阻,可以调节开通关断阈值,从而改善整机效率和 MOS 管尖峰应力。

轻载模式

NE3385 具有轻载模式功能,识别 5us off 间隔后进入轻载模式,当回到重载时,退出轻载模式。实现 LLCSkip 模式或高频 Burst 模式下针对性优化,改善 Skip_OFF 下 HB 震荡时,SR 误触发开通可能性。

轻载模式下的参数调节: TD_ON 增加为 3 倍,由重载时的 80ns 延时增加到 240ns。目的是改善 LLCSkip 模式下 OFF 时间内 SR 误开启现象。

节能模式

NE3385

在系统 Burst off 时间达到 60us 时,SR 进节能模式,系统通过检测 SR VDS 电压高于 VB_TH(1.75V)所持续的时间来判断,当 SR VDS 电压高于 VB_TH 的持续时间超过 TGM_ENT(60us),则 IC 进入节能模式,这时 IC 会关断内部的大部分电路,使 IC 的损耗电流很低,大约为 110uA 左右。

当IC 判断为节能模式时,自动切入轻载模式。

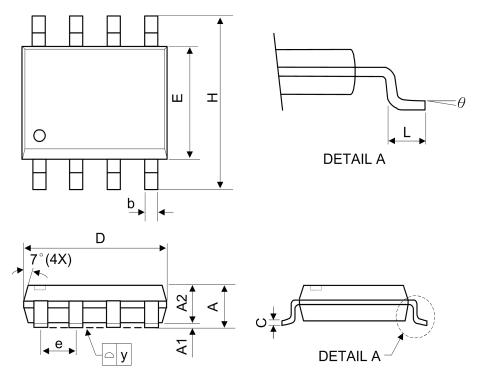
当系统 Burst on 工作时,SR MOS 重新有电流经过,DS 电压超过 VON_TH,IC 检测到该信号后退出节能模式,进入正常的工作模式。

6/8



封装信息

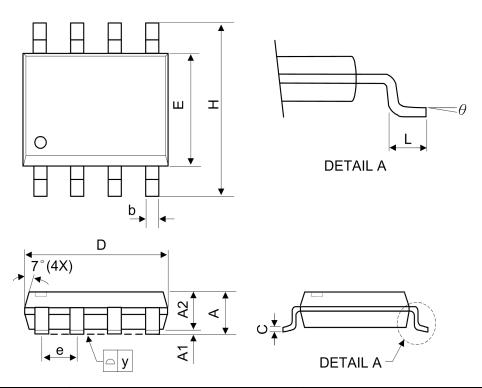
SOP-8



| Symbol | Millimetre | | | Inch | | |
|--------|------------|------|------|--------|-----------|-------|
| | Min | Тур | Max | Min | Тур | Max |
| A | - | - | 1.75 | - | - | 0.069 |
| A1 | 0.1 | - | 0.25 | 0.04 | - | 0.1 |
| A2 | 1.25 | - | - | 0.049 | - | - |
| С | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.0075 | 0.008 | 0.01 |
| D | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 0.185 | 0.193 | 0.2 |
| Е | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 0.146 | 0.154 | 0.161 |
| Н | 5.8 | 6 | 6.2 | 0.228 | 0.236 | 0.244 |
| L | 0.4 | - | 1.27 | 0.015 | - | 0.05 |
| b | 0.31 | 0.41 | 0.51 | 0.012 | 0.016 | 0.02 |
| e | 1.27 BSC | | | | 0.050 BSC | |
| у | - | - | 0.1 | - | - | 0.004 |
| θ | 0° | - | 8° | 0° | - | 8° |



ESOP-8



| Symbol | Millimetre | | | Inch | | |
|--------|------------|------|------|--------|-----------|-------|
| | Min | Тур | Max | Min | Тур | Max |
| A | - | - | 1.75 | - | - | 0.069 |
| A1 | 0.1 | - | 0.25 | 0.04 | - | 0.1 |
| A2 | 1.25 | - | - | 0.049 | - | - |
| С | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.0075 | 0.008 | 0.01 |
| D | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 0.185 | 0.193 | 0.2 |
| Е | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 0.146 | 0.154 | 0.161 |
| Н | 5.8 | 6 | 6.2 | 0.228 | 0.236 | 0.244 |
| L | 0.4 | - | 1.27 | 0.015 | - | 0.05 |
| b | 0.31 | 0.41 | 0.51 | 0.012 | 0.016 | 0.02 |
| e | 1.27 BSC | | | | 0.050 BSC | |
| у | - | - | 0.1 | - | - | 0.004 |
| θ | 0° | - | 8° | 0° | - | 8° |